

# 半导体学报

第8卷 第1期 1987年1月

## 目 录

- 超晶格中空穴子带的理论.....汤 蕙 黄 昆 ( 1 )  
离化吉布斯自由能是远比离化焓为好的表征深能级在禁带中位置的参量.....  
.....陈开茅 秦国刚 ( 11 )  
无定形硅锡合金薄膜特性的研究.....李长健 殷永柏 徐温元 ( 20 )  
MCZ 技术的研究 .....  
.....周士仁 纪彦蜀 孔庆茂 高元恺 王守雨 韩长林 傅择国 ( 26 )  
GaAs 中碳局域模振动红外吸收的温度依赖关系 .....  
.....江德生 宋春英 郑捷飞 许振嘉 ( 33 )  
氧化铁气体传感器研究  
I.  $\gamma$ - $\text{Fe}_2\text{O}_3$  微粒制备及其气敏特性 .....王 弘 曾桓兴 沈瑜生 ( 43 )  
能带结构对 InGaAsP 半导体光增益谱的影响 .....郭长志 黄永箴 ( 49 )  
硅悬键表面态的晶向关系——光电子发射研究.....邢益荣 ( 61 )  
Si:Pd 深能级的  $X\alpha$ -SW 研究.....  
.....唐九耀 唐景昌 黄 绮 冯克安 吴汲安 ( 67 )  
非对称波导 GaAlAs/GaAs 快速边发光管的几何结构及性能 .....  
.....逢永秀 王德宁 龚连根 吴冠群 潘慧珍 吴陈周 ( 76 )

## 研究简报

- GaAs MESFET 电子辐照效应的研究.....  
.....吴凤美 赖启基 徐 岭 龚邦瑞 ( 84 )  
MBE GaAs/AlAs 多量子阱结构的光致发光谱 .....  
.....庄蔚华 滕 达 徐仲英 许继宗 陈宗圭 ( 90 )  
a-Si:H/a-SiN<sub>x</sub>:H 超晶格薄膜的制备及其性质.....  
.....王志超 刘湘娜 何宇亮 吴汝麟 ( 94 )  
一种 GaAs 快速光电导开关.....李锦林 梁东明 张进昌 ( 99 )  
平面型器件欧姆接触的衡量——圆形传输线模型外推法.....陈存礼 徐世晖 ( 102 )  
过渡金属 Ni、Pd、Pt 硅化物/Si(111) 界面的电子态.....徐永年 ( 109 )